
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6467BDQ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 6.8A 8TSSOP</p>
	<p>Datenblätter:  SI6467BDQ-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	SI6467BDQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 6.8A 8TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	850mV @ 450µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.5 mOhm @ 8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.05W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Andere Namen	SI6467BDQ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 6.8A (Ta) 1.05W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Ta)

SI6467BDQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6467BDQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6467BDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6467BDQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6467BDQ-TI-E3 VISHAY VISHAY TSSOP</p>	 <p>SI6467BDQ-T1 VISHAY SI6467BDQ-T1 VISHAY</p>	 <p>SI6467DQ-T1 VISHAY SI6467DQ-T1 VISHAY</p>	 <p>SI6467BDQ-T1TE3 VISHAY VISHAY TSSOP8</p>
 <p>SI6467BDQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 6.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6467BDQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 6.8A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6467DQ-T1-E3 VISHAY SI6467DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI6467DQ SI SI6467DQ SI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI6467BDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6467BDQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6467BDQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6467BDQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI6467BDQ-T1-GE3 Electronic	SI6467BDQ-T1-GE3-Komponenten	SI6467BDQ-T1-GE3-Verteiler	SI6467BDQ-T1-GE3-Bild	SI6467BDQ-T1-GE3-Teil
SI6467BDQ-T1-GE3 Preis	SI6467BDQ-T1-GE3 Hersteller	SI6467BDQ-T1-GE3 Bild	SI6467BDQ-T1-GE3 Aktie	SI6467BDQ-T1-GE3 Inventar
SI6467BDQ-T1-GE3 Neu	SI6467BDQ-T1-GE3 Original	SI6467BDQ-T1-GE3 garantiert	SI6467BDQ-T1-GE3 RFQ	SI6467BDQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited